

烧结 SmCo₅ 合金 750℃ 回火效应与内禀矫顽力^①

潘树明^②

(北京有色金属研究总院)

摘要

用TEM、XRD及XPS技术研究了烧结SmCo₅合金750℃回火效应与内禀矫顽力的关系。发现烧结SmCo₅ 750℃回火后其内禀矫顽力严重降低的根本原因，并不是由于烧结SmCo₅合金的共析分解和氧的增加，而是其共析分解的SmCo₁₇相中存在某些多缺陷的区域，并在反磁化过程中成为反磁化形核中心。

关键词：烧结合金，SmCo₅回火效应，内禀矫顽力

早在1970年，Wenstendorp就发现了烧结SmCo₅合金的750℃回火效应^[1, 2]。该效应的重要现象是：从25℃～750℃，SmCo₅的内禀矫顽力一直下降，至750℃时达到最低值。1972年，Broeder等人指出^[3]，SmCo₅合金在750℃回火一段时间就共析分解为Sm₂Co₇和Sm₂Co₁₇。1973年，Smeggile等人指出，此合金750℃回火内禀矫顽力下降的原因是SmCo₅共析分解为Sm₂Co₇和Sm₂Co₁₇相^[4]。1976年Broeder进一步指出，内禀矫顽力下降的原因是SmCo₅在750℃溶解了更多的氧；因为该合金在这一温度附近，由于氧的富集形成了Sm₂O₃，不仅减弱了对畴壁的钉扎作用，而且促进了反磁化核的形成^[5]。1980年Fidler等人提出，这种效应和个别Sm₂Co₁₇相长大有关^[6]。总之，对SmCo₅合金回火效应的研究与讨论，一直延续至今，且其兴趣有增无减。因为对这个问题的研究不仅能促进矫顽力和磁学理论的发展，而且对制定热处理工艺有重要的实用价值。

我们用TEM、XRD及XPS技术测定了

烧结SmCo₅合金750℃的回火效应与内禀矫顽力，明确提出了自己的观点。以下便详尽地报道这一研究及其结果。

1 实验

1.1 样品制备

将99.8%Sm和99.5%Co在非自耗电弧炉内熔炼（氩气保护）得到铸态合金，再将此铸态合金在有机介质中粉碎到5μm。在1.5T磁场下成形。成形毛坯在1135℃烧结30min，再降到900℃保温1h，急冷到室温，得到热退磁样品。

1.2 SmCo₅样品光电子能谱研究

在室温下测量了用氩离子剥离SmCo₅样品的AES谱。AES的测量条件是：入射电子束能3keV，束流1μA，调试电压6eV，倍增电压1200V，时间常数0.03S，放大倍数40×，真空度2~4×10⁻⁷Pa。

XPS的主要测量条件是：以镁靶辐射作光源，电压8kV，电源30mA。通电50eV。

①于1991年9月8日收到修正稿

②高级工程师

图1示出经750℃回火后的SmCo₅永磁合金从室温到900℃测量的钐、钴元素分凝的实验结果。由该图可见，样品经不同温度回火后，其氧百分量的变化一直不大，且在750℃时无峰值出现。

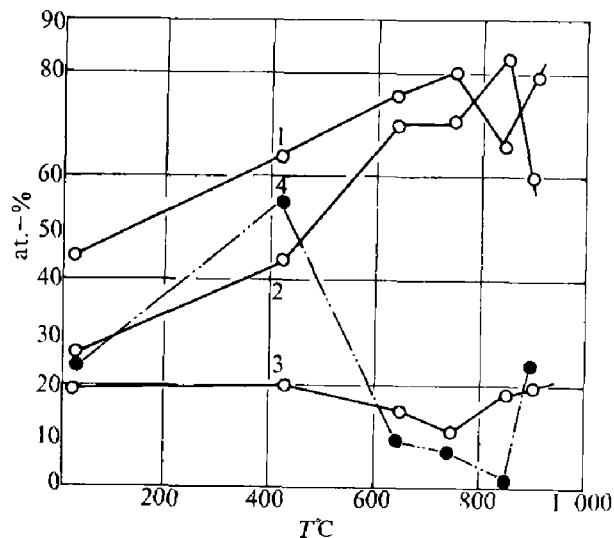


图1 SmCo₅在温度T回火后的Sm, Co, O的分布

1—Sm(表面未溅射); 2—Sm(Ar^+ 溅射5S);
3—O(Ar^+ 溅射5S); 4—Co(Ar^+ 溅射5S)

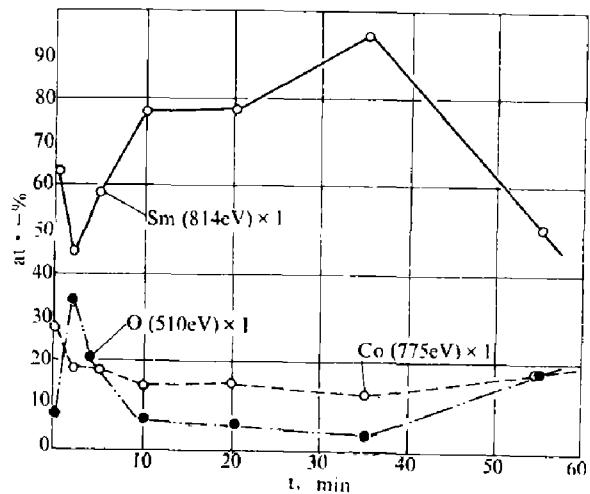


图2 SmCo₅在750℃回火1 h后的Sm、Co、O分布

图2示出，烧结SmCo₅永磁合金样品经750℃回火后的光电子能谱结果。除剥离初期外，也没有发现经750℃回火的SmCo₅永磁合金在750℃附近有氧的峰值出现。

1.3 X-射线衍射分析

X-射线衍射结果表明，在室温下仅有

SmCo₅相。420℃回火1 h便出现了Sm₂Co₁₇和Sm₂Co₇相。表明烧结SmCo₅合金在420℃已发生了共析分解。

1.4 透射电子显微镜的动态观察

实验条件：薄膜样品制备方法是，先用线切割机将样品在垂直易磁化轴方向切成0.25 mm薄片，然后用离子去薄机减薄到100 nm左右，再装于TEM-1000侧插式加热样品台，在加速电压为1000kV、真空度为 2.66×10^{-5} Pa条件下，加温样品并进行动态观察。观察结果表明：SmCo₅样品从室温加热到350℃前没有析出物；当温度升到350℃时，发现有小的析出物；到420℃时，在样品原来无任何沉淀物的位置上，可以清楚地观察到有高度弥散的析出物分布；保温10 min后，该析出物长大到几十nm的尺度，有的甚至已经聚合。经分析这种析出物为Sm₂Co₇相，且其衍射花样中存在明显不同的两套花样。经分析计算分别为Sm₂Co₇和Sm₂Co₁₇相，证明SmCo₅在420℃确已发生共析分解，此外Sm₂Co₁₇相还有图3所示的缺陷。

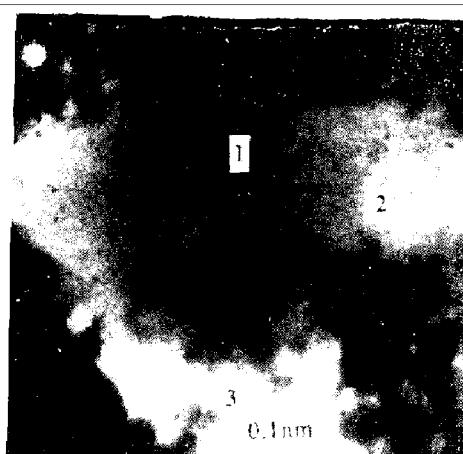


图3 Sm₂Co₁₇相上的缺陷(1, 2, 3)

其实Sm₂Co₁₇相的缺陷从600℃到800℃均可见到，在750℃时尤为明显；此时将SmCo₅保温80 min后，还发现有条纹状物出现。这种条纹状物是否为新相还有待于进一步研究。

1.5 样品内禀矫顽力随回火温度的变化

将热退磁样品放在炉内，分别加热到

250、350、420、500、600、750、850、900 和 1 000℃时回火 1 h, 再在室温下用 CL6-1 磁参数测量仪测量, 其结果如图 4 所示。从该图看出, 内禀矫顽力随温度的升高呈非线性变化, 且在 750℃时矫顽力最低。

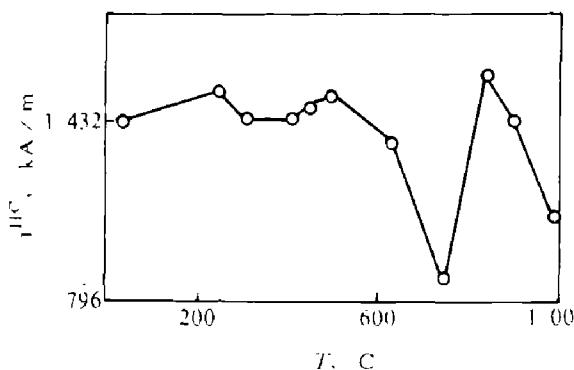


图 4 SmCo₅ 样品经不同温度(*T*)回火 1 h 后的矫顽力 *H^c*

2 讨论

烧结 SmCo₅ 合金在 420℃回火 20 min 后的 X-射线衍射谱表明, 部分 SmCo₅ 相共析已分解为 Sm₂Co₇ 和 Sm₂Co₁₇ 两相。但从图 4 看, SmCo₅ 在 420℃的内禀矫顽力和室温下的相比并无下降。所以, 认为 SmCo₅ 在 750℃回火出现的矫顽力下降, 是由于 SmCo₅ 共析分解所致的理由不能令人信服。

光电子能谱研究结果表明, SmCo₅ 在 750℃回火后并无氧的峰值。认为 SmCo₅ 在 750℃的矫顽力下降, 主要是由于氧的富集所致, 也是不妥的。

透射电镜对 SmCo₅ 样品动态观察发现析出的 Sm₂Co₁₇ 相不仅能继续长大, 且其缺陷会随着时间增长而增大, 在 750℃保温 80 min 后还观察到条纹状物。

综上, 我们认为 SmCo₅ 矫顽力下降的主要原因在于: 温度变化产生 Sm、Co 的分凝, Sm、Co 又产生短程偏聚; 由于这种分凝和偏聚造成 Sm₂Co₁₇ 的缺陷, 正是这种缺陷成为反磁化形核中心, 使 SmCo₅ 的矫顽力下

降^[7]。

SmCo₅ 样品在 750℃回火后矫顽力严重下降的原因, 则是由于各晶粒中反磁化形核中心的产生和长大。这些形核中心的尺寸相当大, 其内部的磁各向异性很小。在给定反磁化核半径 *R* 的条件下, 形核场 *H_n* 的理论最小值可由下式计算:

$$2M_sH_n(4/3)\pi R^3 = 4\pi R^2\gamma$$

$$\therefore H_n = (3/2)\gamma / M_s R \quad (1)$$

式中 γ 为畴壁能密度;

M_s 为饱和磁化强度

由于 Sm₂Co₁₇ 的 γ / M_s 只是 SmCo₅ 的 $1/3$, 因此在给定 *R* 下的 Sm₂Co₁₇ 相中容易形核。在 *R*=10 和 100 nm 时, 算得 Sm₂Co₁₇ 相中形核中心的 *H_n* 值分别为: 2 385 kA/m 和 238.5 kA/m。由计算看出, 实验中观察到的 *H^c* 严重下降, 多起因于大于 100 nm 的形核中心。在较低温区回火时尽管 Sm₂Co₁₇ 析出相长大, *H^c* 却往往上升。因此可以认为, Sm₂Co₁₇ 析出相本身不是形核中心和造成矫顽力严重下降的原因。

3 结论

1 用 1 000 kV 超高压电子显微镜对样品进行动态观察实验和 X-射线衍射实验表明: 烧结 SmCo₅ 合金在 420℃到 750℃回火会出现共析分解, 即 SmCo₅ 的部分母相共析分解为 Sm₂Co₇ 和 Sm₂Co₁₇ 相;

2 SmCo₅ 合金在 420℃回火 20 min 时部分 SmCo₅ 相已产生共析分解, 但此时矫顽力并无下降。可以认定 SmCo₅ 合金的共析分解不是其 750℃回火后矫顽力下降的根本原因;

3 光电子能谱实验表明: SmCo₅ 样品在 750℃回火时没有出现氧的峰值。

在实验中曾得到田凤祚、孙继光、任世宽的帮助, 在成文中曾得到金汉民教授的帮助, 在此一并致谢。

Metals, 1972, 29: 65

参考文献

- 1 Wenstendorp F F. Solid State Communications, 1970, 8: 139
- 2 周寿增等。稀土永磁材料及其应用。北京: 冶金工业出版社, 1990, 236
- 3 Den Broeder F J A, Buschow K H J. J. less-Common
- 4 Smegalle J G et al. In: AIP Conf. Proc., 1973, 1144
- 5 den Broeder F J A, et al. J. Appl. Phys., 1976, 47: 2688
- 6 Fidler J et al. J. M. M. M., 1980, 15-18: 1461
- 7 Pan Shuming (潘树明), et al. In: Proc. 7th International REPM Workshop, 1983.291

(上接 P55)

参考文献

- 1 Sauthoff G Z. Metallkde, 1989, 80: 337
- 2 Ronald T M F. Adv. Mater. Proc., 1989, 135: 39
- 3 Shechtman D, Blackburn M J, Lipsitt H A. Metall. Trans., 1974, 5A: 1373
- 4 Lipsitt H A, shechtman D, Schafrik R E. Metall. Trans., 1975, 6A: 1991
- 5 Qu X H, Huang B Y, Lu H B, Huang P Y. In: Proceedings of C- MRS International Symposium, Vol. 2, 1990, 737
- 6 Hug G, Loisau A, Losalmoni A. Phil. Mag., 1986, 54A: 47
- 7 Qu X H, Huang B Y, Qian Y, Kong X Y, Lu H B, Huang P Y. In: Proceedings of Sixth JIM International Symposium on Intermetallic Compounds—Structure and Mechanical properties, 1991, Japan, 797
- 8 Hirsch P, Howie A, Nichoson R B, Pashley D W, Whelan M I. Electron Microscopy of Thin Crystals. Huntington, New York: Robert E Krieger Publishing Company, 1977
- 9 Cottrell A H, Bilby B A. Phil. mag., 1951, 42: 329